









 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TC58BVG2S0HBAI4</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TC58BVG2S0HBAI4</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 4G PARALLEL 63TFBGA</p> <p>Datenblätter:  TC58BVG2S0HBAI4.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TC58BVG2S0HBAI4
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 4G PARALLEL 63TFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	63-TFBGA (9x11)
Serie	Benand™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	63-VFBGA
Andere Namen	ASTC58BVG2S0HBAI4
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TC58BVG2S0HBAI4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58BVG2S0HBAI4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58BVG2S0HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58BVG2S0HBAI4 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TC58BVG1S3HTAIO Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58BVG2S0HTA00 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58BVG1S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58BVG2S0HBAI4 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 63FBGA</p>
 <p>TC58BVG2S0FTA00 TOSHIBA TOSHIBA 14+</p>	 <p>TC58BVG1S3HTAIO Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TC58BVG2S0HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TC58BVG2S0HTAIO Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58BVG2S0HBAI4 Toshiba Memory America, Inc.	TC58BVG2S0HBAI4 Datenblatt	TC58BVG2S0HBAI4-Datenblätter	TC58BVG2S0HBAI4 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TC58BVG2S0HBAI4
TC58BVG2S0HBAI4 Electronic	TC58BVG2S0HBAI4-Komponenten	TC58BVG2S0HBAI4-Verteiler	TC58BVG2S0HBAI4-Bild	TC58BVG2S0HBAI4-Teil
TC58BVG2S0HBAI4 Preis	TC58BVG2S0HBAI4 Hersteller	TC58BVG2S0HBAI4 Bild	TC58BVG2S0HBAI4 Aktie	TC58BVG2S0HBAI4 Inventar
TC58BVG2S0HBAI4 Neu	TC58BVG2S0HBAI4 Original	TC58BVG2S0HBAI4 garantiert	TC58BVG2S0HBAI4 RFQ	TC58BVG2S0HBAI4 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited